



华晶分立器件

3DA4544

高频放大管壳额定双极型晶体管

1 概述与特点

3DA4544 硅 NPN 型高频高压大功率晶体管，适用于彩色电视机色输出电路及行推动电路。其特点如下：

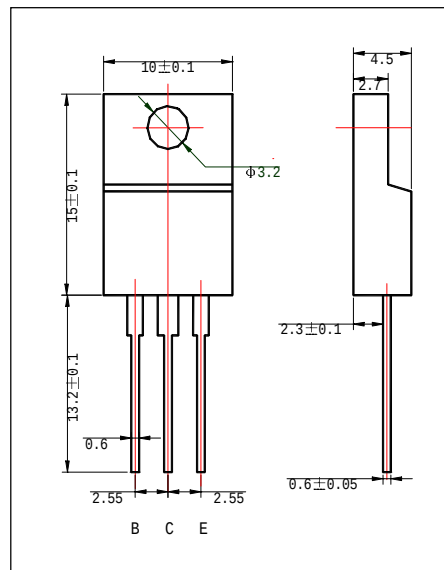
- 击穿电压高
- 反向漏电流小
- 饱和压降低
- 封装形式：TO-220F

2 电特性

2.1 极限值

除非另有规定， $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参 数 名 称	符 号	额 定 值	单 位
集电极-基 极电压	V_{CB0}	300	V
集电极-发射极电压	V_{CE0}	300	V
发射极-基 极电压	V_{EB0}	7	V
集电极电流	I_C	0.1	A
耗散功率	$T_a=25^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	W
	$T_c=25^{\circ}\text{C}$		
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$



2.2 电参数

除非另有规定， $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	规 范 值			单 位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I_{CB0}	$V_{CB}=300\text{V}, I_E=0$			1	μA
发射极-基极截止电流	I_{EB0}	$V_{EB}=7\text{V}, I_C=0$			1	μA
共发射极正向电流传输比的静态值	h_{FE}	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=20\text{mA}$	30		200	
集电极-发射极饱和电压	V_{CEsat}	$I_C=10\text{mA}, I_B=1\text{mA}$			1	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=20\text{mA}$	50			MHz
脉冲测试 $t_p \leq 300 \mu\text{s}, \delta \leq 2\%$						

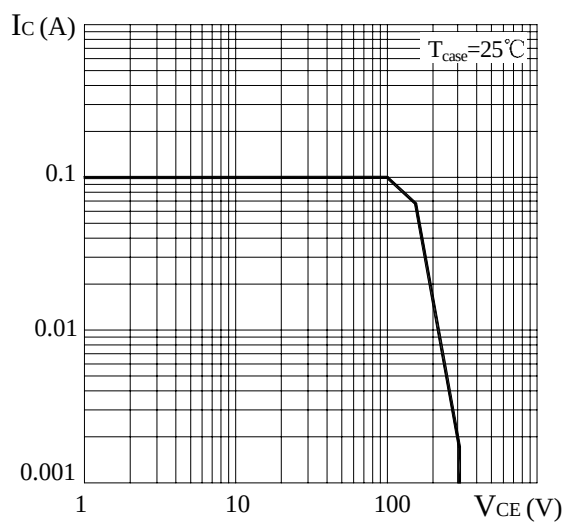
h_{FE} 分档：R：30---80 O：60---120 Y：100---200

无锡华晶微电子股份有限公司

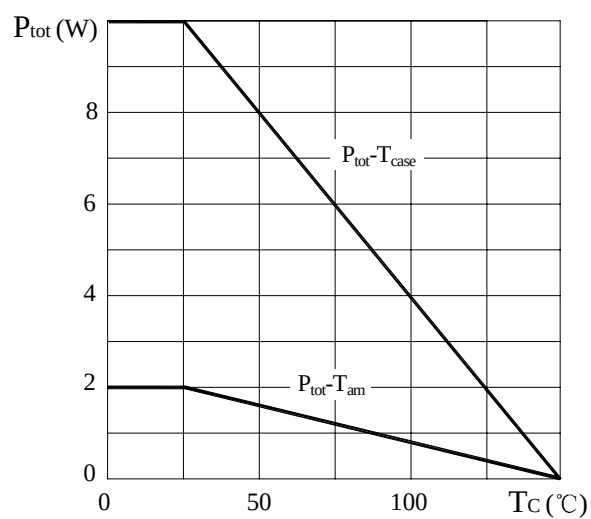
地址：江苏省无锡市梁溪路 14 号 电话：(0510)5807228-2268、2299 传真：(0510)5800360

3 特性曲线

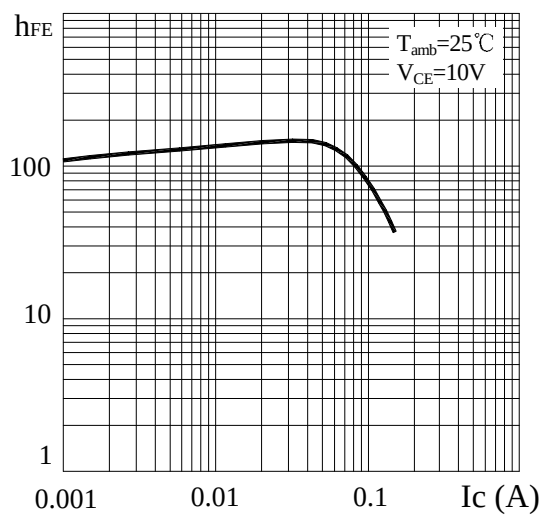
安全工作区(直流)



P_{tot} - T 关系曲线



h_{FE} - I_C 关系曲线



V_{CEsat} - I_C 关系曲线

